

## SiC 肖特基二极管

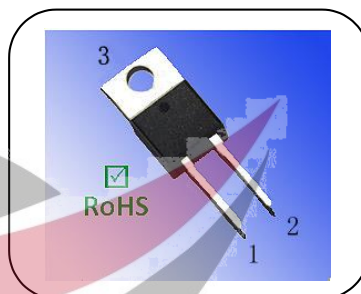
### 特点

零反向恢复电流  
 高频工作  
 与温度无关的开关特性  
 极快的开关特性

$V_{RRM}$	650V
$I_F, T_c=150^\circ\text{C}$	10 A
$Q_c$	29nC

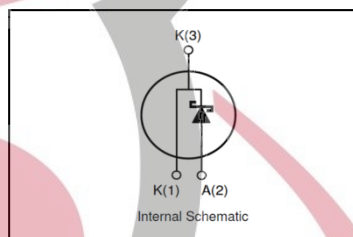
### 优点

基本无开关损耗  
 对散热器要求降低  
 效率更高  
 并联器件不会导致热失控



### 应用

开关电源  
 功率因数校正  
 电机驱动器



### 额定值

参数	符号	值	单位	测试条件
反向重复峰值电压	$V_{RRM}$	650	V	
反向浪涌峰值电压	$V_{RSM}$	650	V	
直流反向峰值电压	$V_{DC}$	650	V	
持续直流电流	$I_F$	10	A	$T_c=150^\circ\text{C}$
正向重复峰值浪涌电流	$I_{FRM}$	51	A	$T_c=25^\circ\text{C}, t_p=10\text{ms}, \text{Half Sine Pulse } D=0.1$
正向不重复浪涌峰值电流	$I_{FSM}$	67	A	$T_c=25^\circ\text{C}, t_p=10\text{ms}, \text{Half Sine Pulse}$
功率耗散	$P_{tot}$	133.9	W	$T_c=25^\circ\text{C}$
工作结温范围	$T_j$	-55 至 +175	$^\circ\text{C}$	
储存温度范围	$T_{stg}$	-55 至 +175	$^\circ\text{C}$	

### 热特性

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
结到壳热阻	$R_{thjc}$		1.12		$^\circ\text{C}/\text{W}$	

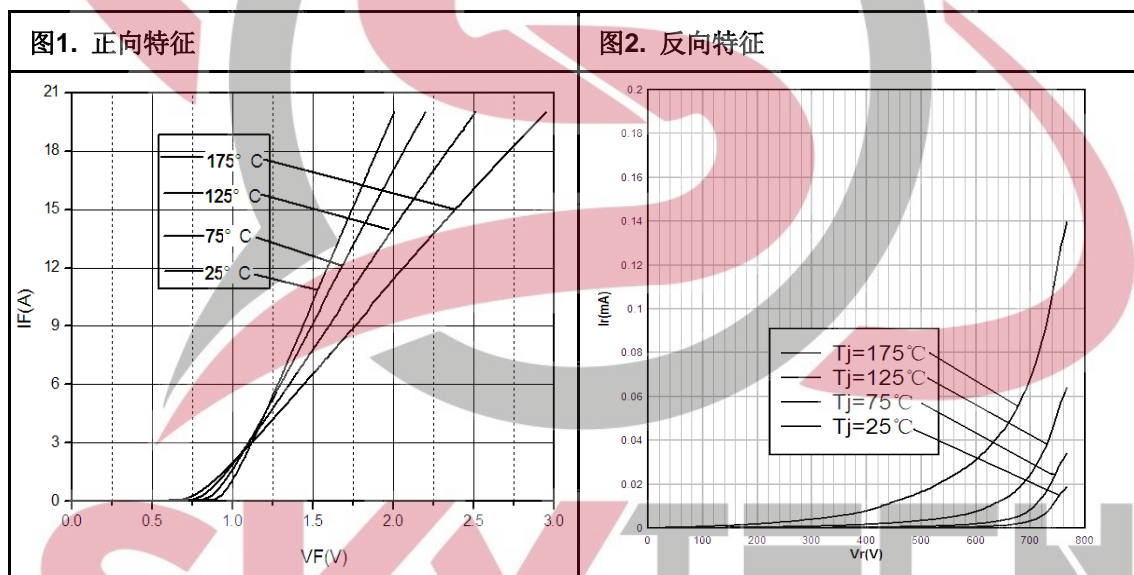
2018.01-Rev.A



### 电特性

参数	符号	典型值	最大值	单位	测试条件
正向电压	$V_F$	1.48 1.82	1.7 2.5	V	$I_F=10A, T_j=25^\circ C$ $I_F=10A, T_j=175^\circ C$
反向电流	$I_R$	1.2 45.0	50 200	uA	$V_R=650V, T_j=25^\circ C$ $V_R=650V, T_j=175^\circ C$
总电容电荷	$Q_C$	29		nC	$V_R=400V, T_j=150^\circ C$ $Q_C = \int_0^{V_R} C(V)dV$
总电容	C	516 57 56		pF	$V_R=0V, T_j=25^\circ C, f=1MHz$ $V_R=200V, T_j=25^\circ C, f=1MHz$ $V_R=400V, T_j=25^\circ C, f=1MHz$

### 典型特性



2018.01-Rev.A



图 3. 不同负载下的电流

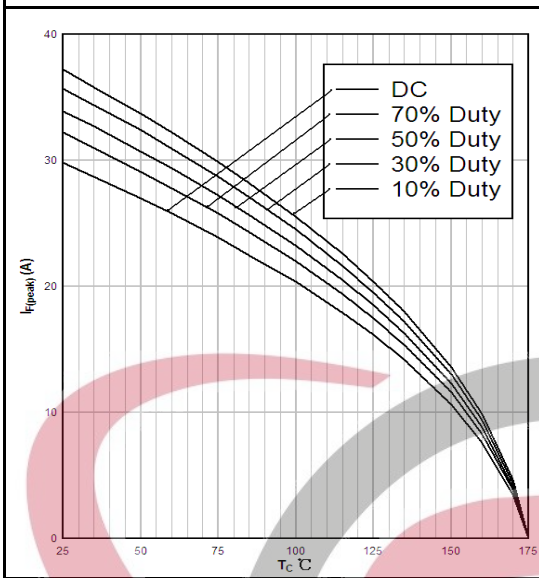


图 4. 电容与反向电压的关系

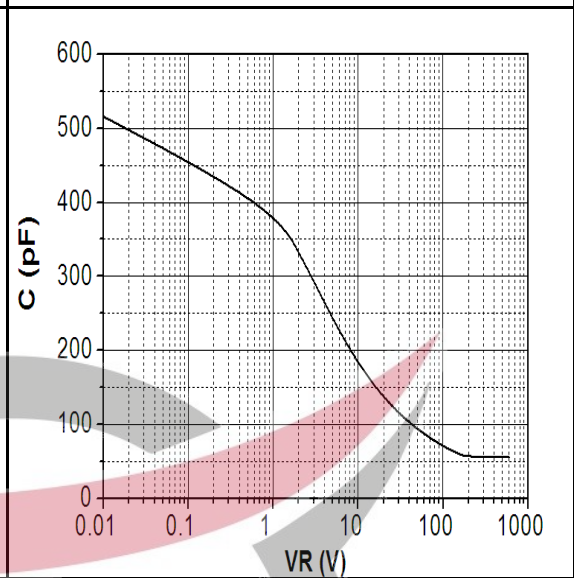


图 5. 功率降额

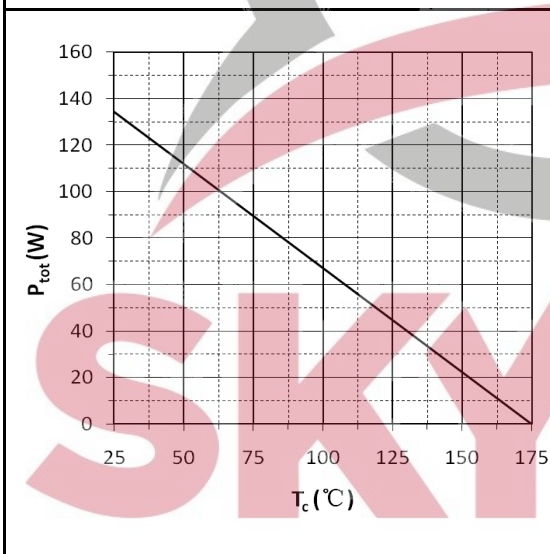
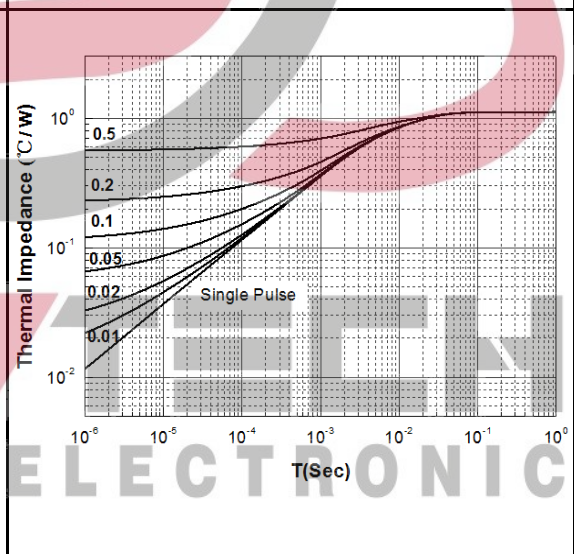
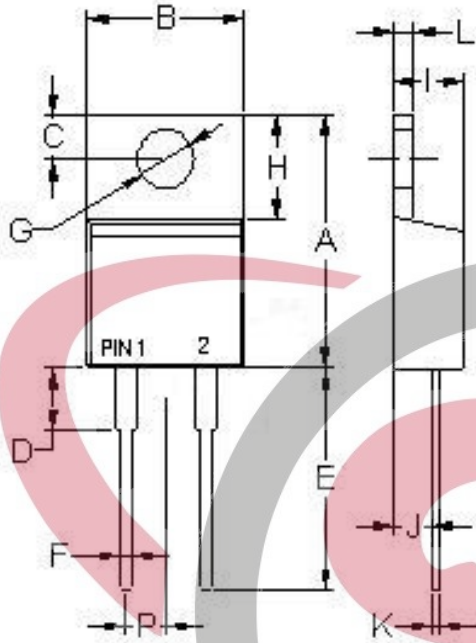


图 6. 瞬态热阻抗



封装形式: TO-220



尺寸	最小值	最大值
A	14.55mm	15.32mm
B	9.52mm	10.50mm
C	2.62mm	2.87mm
D	3.56mm	4.06mm
E	13.0mm	14.3mm
F	0.68mm	0.94mm
G	3.74mm	3.91mm
H	5.84mm	6.86mm
I	4.44mm	4.86mm
J	2.54mm	2.79mm
K	0.35mm	0.64mm
L	1.14mm	1.40mm
P	2.41mm	2.67mm

SKYTECH  
ELECTRONIC

2018.01-Rev.A

